

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月22日(22.05.2025)



(10) 国際公開番号
WO 2025/105309 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) C23C 14/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/039839
- (22) 国際出願日: 2024年11月8日(08.11.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-193864 2023年11月14日(14.11.2023) JP
- (71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX ADVANCED METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058417 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 (JP).
- (72) 発明者: 守岡 明良 (MORIOKA, Akira); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP). 西村 康佑 (NISHIMURA, Kosuke); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP). 太齋 貴文 (DASAI, Takafumi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP).
- (74) 代理人: アクシス国際弁理士法人 (AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号新橋アイマークビル (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,

KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: SPUTTERING TARGET ASSEMBLY AND FILM

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット組立体及び膜

(57) Abstract: The purpose of the present disclosure is to provide a tungsten sputtering target assembly with improved peel strength. In one aspect, the present disclosure provides the following invention: a sputtering target assembly equipped with a target, a backing plate, and an insert, wherein the target comprises W, the backing plate includes Ti or a Ti alloy, the insert includes Cu or a Cu alloy, and the average particle size of the target is 20 μm or more.

(57) 要約: 本開示は、剥離強度を改善したタングステンスパッタリングターゲット組立体を提供することを目的とする。一側面において、本開示は以下の発明を提供する。ターゲットと、バックキングプレートと、インサートとを備えるスパッタリングターゲット組立体であって、前記ターゲットはWから成り、前記バックキングプレートはTi又はTi合金を含み、前記インサートはCu又はCu合金を含み、前記ターゲットの平均粒径が20 μm以上である、スパッタリングターゲット組立体。

WO 2025/105309 A1